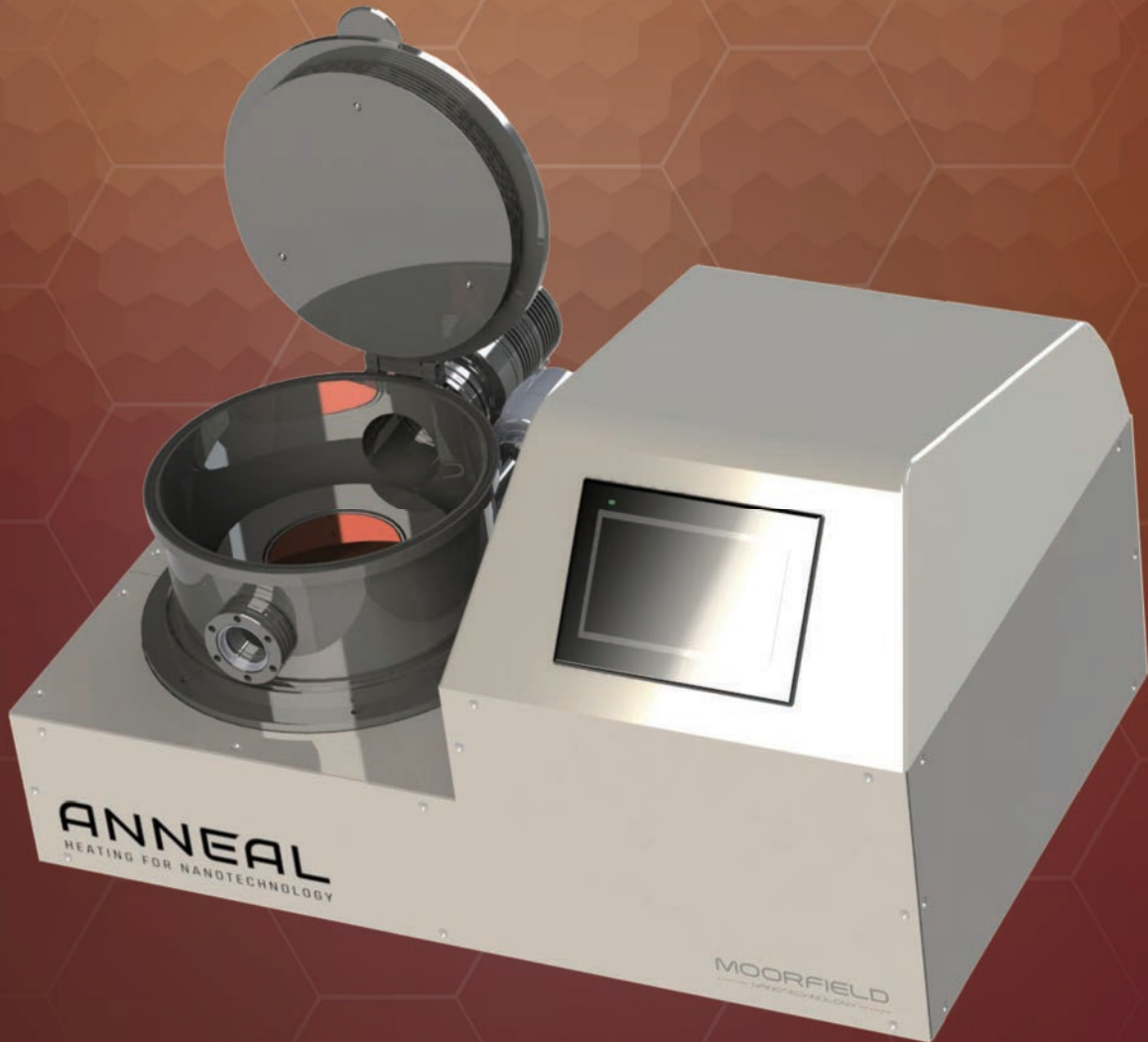


ANNEAL

卓上型ウエハーアニール装置 Max1000°C

High-temperature substrate annealing up to 1000 °C



Φ2inch, Φ4inchウエハーの最高1000°Cまでの高温均一熱処理

最大3基までのマスフローによる高精度圧力制御

PLC自動プロセス制御, 操作性に優れた7inchタッチパネルインターフェイス

優れた基本性能: 真空度 5×10^{-7} mbar



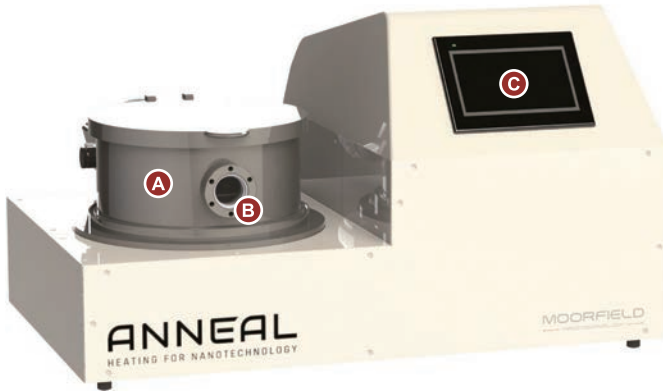
Thermocera

endless possibility_thermal engineering

ANNEAL

- A プロセス真空チャンバー
- B フロントビューポート
- C タッチスクリーン

- D 外部出力端子
- E ターボ分子ポンプ
- F 電源接続口/ヒューズ
- G ガス/冷却水接続



3台までのMFCによる高精度プロセス雰囲気制御、操作性に優れたタッチパネル、安定した温度制御・優れた面内均一性プロセス条件に合わせて3種類のヒーター熱源を選択可能な加熱ステージ、多目的なR&D用卓上ウエハーアニール装置

ANNEAL卓上型ウエハーアニール装置は、ウエハー等の基板を安定したプロセス雰囲気にて高温処理可能な研究開発用アニール装置です。高真空SUSチャンバー内に設置した加熱ステージにより最高1000℃までの高温熱処理が可能です。チャンパー内にはヒートシールドが設置されインターロックにて安全を確保されており、フロントビューポート、ドライスクロールポンプ、APCプロセス自動圧力制御システムなどのオプションも豊富に揃えております。

●【ハロゲンランプヒーター:Max500℃】

遠赤外線加熱による高効率・高速基板加熱。基板温度で約350℃までのアニール処理が可能。最も廉価なオプションですが、急速加熱・急冷ができ、さらに均一熱処理にも優れており、コストパフォーマンスの高い発熱源です。

●【C/Cコンポジットヒーター:Max1000℃】

C/Cコンポジット素線を使用することにより、最高制御温度1000℃、基板温度約850℃程度までの高温アニール処理が可能です。一般的な抵抗発熱体と比較し機械的強度に優れている為熱変形が少なく、又急速昇温も可能です。

*C/Cコンポジットは350℃以上より酸化します為、O₂使用の際はSiCコーティングをご使用下さい。

●【SiCコーティング・グラファイトヒーター:Max1000℃】

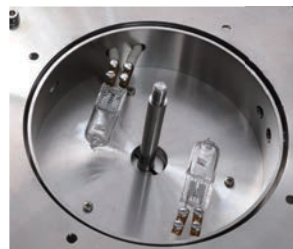
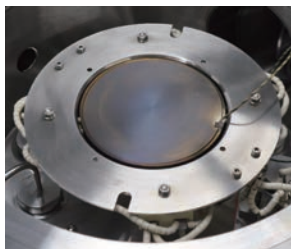
最高制御温度1000℃、基板温度で約850℃までの超高温アニール処理が可能です。SiCコーティング処理により、高温環境下でもC/Cコンポジット発熱体の酸化を防ぎます。



ANNEAL

※外形寸法:750(W) x 500(D) x 400(H)mm

Technical Specification	
ウエハーサイズ	最大Φ6inchサイズ
プロセスガス	最大3系統 MFC付属
真空排気系	ターボ分子ポンプ、ロータリーポンプ、WRGワイドレンジゲージ
到達真空度	5×10 ⁻⁵ Pa
温度センサー	Kタイプ熱電対
オプション	APC プロセス圧力自動制御パッケージ, ドライポンプ



左: ランプ加熱ヒーターステージ
水冷電極式

中: ランプ加熱ヒーターステージ
平板下ヒーターバルブ部写真

右: CCコンポジットヒーターステージ
最高使用温度 1000℃

Distributor : Japan

Thermocera endless possibility_thermal engineering

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 新槇町ビル別館第一2階
Tel:03-6214-3033 Fax:03-6214-3035 E-mail:sales@thermocera.com